“28纳米及先导工艺集成电路可制造性设计关键技术与应用”荣获中国电子学会科学技术奖二等奖

稿件来源：EDA中心 郭叶 发布时间：2019-05-05

在4月20—21日召开的第十四届中国电子信息技术年会上，微电子所 “28纳米及先导工艺集成电路可制造性设计关键技术与应用”项目荣获中国电子学会科学技术奖二等奖。

“28纳米及先导工艺集成电路可制造性设计关键技术与应用”项目由EDA中心陈岚研究员领衔的先进集成电路设计及EDA技术团队完成，团队面向国际发展前沿和国家重大需求，以集成电路设计重大应用问题为牵引，系统深入的研究了芯片设计与工艺协同的技术，CMP新型工艺精确建模技术，高性能版图数据并行处理技术，基于物理知识库的设计与工艺协同优化等DFM核心技术，形成了系统的技术体系，取得了先进纳米工艺可制造性设计解决方案、快速大版图数据处理算法、10多套PDK/iPDK/ePDK以及通用IP电路等系列原创性科技成果，已在国内龙头企业进行应用验证并获得了高度评价，为我国先导工艺的应用推广做出了重要贡献。

相关研究工作得到了国家科技重大专项课题、国家自然科学基金项目和北京市科委项目、中科院等项目的资助。

(http://www.cas.cn/)

中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029
单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn
京公网安备110402500036号

(//bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0A789CCE54264DB4E053022819ACB924)